

Germanium PNP Transistor

GF105

15V / 15mA

DATASHEET

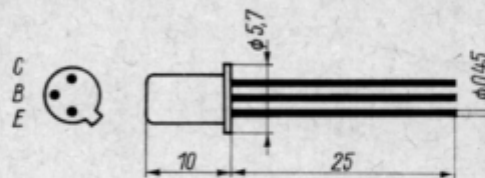
OEM – RFT

Source: RFT Datenbuch Germanium Transistoren 71/72

RFT
electronic

GF 105

Germanium-pnp-Hochfrequenztransistor der Bauform A 3/25-a und A 3/25-b nach TGL 11 811 für Verstärker-, Misch- und Oszillatorstufen.



Masse ca. 0,4 g

Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CBO}$	= 15 V
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO}$	= 10 V
Kollektorstrom	$-I_{CL}$	= 15 mA
Emitterstrom	I_{EL}	= 15 mA
Basisstrom	$-I_{BL}$	= 5 mA
Sperrschichttemperatur	θ_{jL}	= 75 °C
Umgebungstemperatur	θ_{aL}	= -40 °C bis +65 °C
Wärmewiderstand	R_{thja}	≲ 0,5 grad/mW



KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
Stammbetrieb Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

57

GF 105		RFT electronic		
Statische Kennwerte		Min.	Typ	Max.
Kollektor-Basis-Reststrom $-U_{CB} = 6\text{ V}$	$-I_{CBO}$		1,5 μA	10 μA
Kollektor-Basis-Reststrom $-U_{CB} = 15\text{ V}$	$-I_{CBO}$		50 μA	500 μA
Kollektor-Emitter-Reststrom $-U_{CE} = 6\text{ V}$	$-I_{CEO}$		200 μA	600 μA
Kollektor-Emitter-Reststrom $-U_{CE} = 6\text{ V}$	$-I_{CES}$			25 μA
Emitter-Basis-Reststrom $-U_{EB} = 10\text{ V}$	$-I_{EBO}$		50 μA	500 μA
Dynamische Kennwerte				
Grenzfrequenz $-U_{CE} = 6\text{ V}$ $I_C = 0,5\text{ mA}$ $f = 3\text{ MHz}$	f_{h21b}	7 MHz	10,5 MHz	
Kurzschlußstromverstärkung $-U_{CE} = 6\text{ V}$ $I_C = 2\text{ mA}$ $f = 1\text{ kHz}$	h_{21E}	20		110
Rauschmaß $-U_{CE} = 6\text{ V}$ $-I_C = 0,5\text{ mA}$ $f = 2\text{ MHz}$ $\Delta f = 10\text{ kHz}$ $R_o = 1\text{ k}\Omega$	F	11 dB		15 dB
Vierpolparameter	g_{11e}		0,7 mS	3,3 mS
	C_{11e}		110 pF	250 pF
	g_{12e}		2 μS	5 μS
	C_{12e}		7 pF	14 pF
	Y_{21e}	10 mS	16 mS	
	g_{22e}		30 μS	250 μS
	C_{22e}		29 pF	35 pF

Stromverstärkungs-
gruppe

Bestellbeispiel für einen Transistor Transistor GF 108

KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
Stambetrieb Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

58